

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:

Shunji BABA et al.

Group Art Unit:

Serial No.:

Examiner:

Filed: January 4, 2001

For: METHOD OF MOUNTING CHIP ONTO PRINTED CIRCUIT BOARD IN
SHORTENED WORKING TIME



**SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIOR
FOREIGN APPLICATION IN ACCORDANCE WITH
THE REQUIREMENTS OF 37 C.F.R. § 1.55**

Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

In accordance with the provisions of 37 C.F.R. § 1.55, the applicant(s) submit(s)
herewith a certified copy of the following foreign application(s):

Japanese Patent Application No. 2000-139887

Filed: May 12, 2000

Japanese Patent Application No. 2000-334550

Filed: November 1, 2000

It is respectfully requested that the applicant(s) be given the benefit of the foreign filing
date, as evidenced by the certified papers attached hereto, in accordance with the requirements
of 35 U.S.C. § 119.

Respectfully submitted,
STAAS & HALSEY LLP

Date: January 4, 2001

By: 

H. J. Staas
Registration No. 22,010

700 Eleventh Street, N.W., Suite 500
Washington, D.C. 20001
Telephone: (202) 434-1500
Facsimile: (202) 434-1501

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2000年 5月12日

出 願 番 号
Application Number:

特願2000-139887

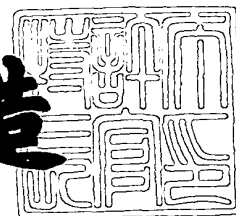
出 願 人
Applicant (s):

富士通株式会社

2000年12月 1日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3098322

【書類名】 特許願

【整理番号】 0051106

【提出日】 平成12年 5月12日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 21/60 311

【発明の名称】 半導体チップの製造方法およびその実装方法

【請求項の数】 6

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

 【氏名】 馬場 俊二

【特許出願人】

 【識別番号】 000005223

 【氏名又は名称】 富士通株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100105094

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 山▲崎▼ 薫

 【電話番号】 03-5226-0508

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 049618

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

 【包括委任状番号】 9803088

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体チップの製造方法およびその実装方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 表面から導電バンプを突出させるウェハーを配置する工程と、薄膜部材の表面に付着するアンダーフィル材膜をウェハーの表面に転移させる工程とを備えることを特徴とする半導体チップ向けアンダーフィル材の供給方法。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の半導体チップ向けアンダーフィル材の供給方法において、前記ウェハーの表面に前記アンダーフィル材膜を転移させるにあたって、アンダーフィル材膜を軟化させた上でウェハーの表面にアンダーフィル材膜を押し付ける工程と、アンダーフィル材膜を硬化させた上でアンダーフィル材膜から薄膜部材を剥離する工程とをさらに備えることを特徴とする半導体チップ向けアンダーフィル材の供給方法。

【請求項 3】 個々の半導体チップを拾い上げることに先立ってウェハーを裏返すことを特徴とする半導体チップの実装方法。

【請求項 4】 ウェハーの表面に導電バンプを形成する工程と、第 1 支持部材上でウェハーにダイシング加工を施し、個々の半導体チップを切り出す工程と、第 1 支持部材に第 2 支持部材を覆い被せ、第 1 および第 2 支持部材の間に複数の半導体チップを挟み込む工程と、第 2 支持部材との間に半導体チップを挟み込んだまま第 1 支持部材を裏返す工程と、第 1 支持部材を取り去った後、個々の半導体チップを拾い上げる工程とを備えることを特徴とする半導体チップの実装方法。

【請求項 5】 ウェハーの表面に導電バンプを形成する工程と、ウェハーを裏返し、ウェハーの裏面に樹脂層を形成する工程とを備えることを特徴とする半導体チップの製造方法。

【請求項 6】 請求項 5 に記載の半導体チップの製造方法において、前記樹脂層を形成するにあたって、薄膜部材の表面に付着する樹脂膜をウェハーの裏面に転移させる工程をさらに備えることを特徴とする半導体チップの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ウェハーから個々の半導体チップを作り出す半導体チップの製造方法や、基板上に半導体チップを実装する半導体チップの実装方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

いわゆる I C といった半導体チップはシリコンウェハーから切り出される。切り出された半導体チップは続いてプリント配線基板に実装される。こうして半導体チップが実装されると、半導体チップの入出力バンプはプリント配線基板の表面に受け止められる。入出力バンプは半導体チップとプリント配線基板との間に電氣的接続を確立する。

【 0 0 0 3 】

半導体チップとプリント配線基板との間にはいわゆるアンダーフィル材が充填される。このアンダーフィル材は、入出力バンプの腐食といった劣化を防止するとともに、半導体チップとプリント配線基板との接合強度を高める。

【 0 0 0 4 】

【発明が解決しようとする課題】

一般に、アンダーフィル材の供給にあたってはディスペンサが用いられる。ディスペンサは個々の半導体チップごとに順番にアンダーフィル材の流体を吐き出す。したがって、このアンダーフィル材の供給にはかなりの作業時間が必要とされる。

【 0 0 0 5 】

また、半導体チップの製造にあたって、シリコンウェハーの表面には上向きの入出力バンプが形成される。こうしたシリコンウェハーから切り出された個々の半導体チップは、個別に裏返された後、プリント配線基板上に搭載される。こうした半導体チップの裏返しにはかなりの作業時間が必要とされる。

【 0 0 0 6 】

本発明は、上記実状に鑑みてなされたもので、半導体チップの実装にあたって作業時間を短縮することができる半導体チップの実装方法を提供することを目的

とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、第1発明によれば、表面から導電バンプを突出させるウェハーを配置する工程と、薄膜部材の表面に付着するアンダーフィル材膜をウェハーの表面に転移させる工程とを備えることを特徴とする半導体チップ向けアンダーフィル材の供給方法が提供される。

【0008】

かかるアンダーフィル材の供給方法によれば、ウェハーに含まれる個々の半導体チップに対して一括してアンダーフィル材は供給されることができる。したがって、各半導体チップごとに個別にアンダーフィル材が供給される場合に比べて、作業時間は著しく短縮されることができる。しかも、このように予め各半導体チップにアンダーフィル材が供給されれば、後続する半導体チップの実装作業は簡素化されることができる。

【0009】

ウェハーの表面にアンダーフィル材膜を転移させるにあたって、半導体チップ向けアンダーフィル材の供給方法は、アンダーフィル材膜を軟化させた上でウェハーの表面にアンダーフィル材膜を押し付ける工程と、アンダーフィル材膜を硬化させた上でアンダーフィル材膜から薄膜部材を剥離する工程とをさらに備えてもよい。こういったアンダーフィル材膜の転移は、ウェハーから各半導体チップが切り出される以前に実施されてもよく、各半導体チップが切り出された後に実施されてもよい。

【0010】

第2発明によれば、個々の半導体チップを拾い上げることに先立ってウェハーを裏返すことを特徴とする半導体チップの実装方法が提供される。

【0011】

かかる半導体チップの実装方法によれば、ウェハーに含まれる個々の半導体チップは一括して裏返される。したがって、個々の半導体チップごとに半導体チップが裏返される場合に比べて、作業時間は著しく短縮されることができる。

【 0 0 1 2 】

第 3 発明によれば、ウェハーの表面に導電バンプを形成する工程と、第 1 支持部材上でウェハーにダイシング加工を施し、個々の半導体チップを切り出す工程と、第 1 支持部材に第 2 支持部材を覆い被せ、第 1 および第 2 支持部材の間に複数の半導体チップを挟み込む工程と、第 2 支持部材との間に半導体チップを挟み込んだまま第 1 支持部材を裏返す工程と、第 1 支持部材を取り去った後、個々の半導体チップを拾い上げる工程とを備えることを特徴とする半導体チップの実装方法が提供される。

【 0 0 1 3 】

かかる半導体チップの実装方法によれば、第 1 および第 2 支持部材の間に挟み込まれた複数の半導体チップは一括して裏返されることができる。したがって、個々の半導体チップごとに半導体チップが裏返される場合に比べて、作業時間は著しく短縮されることができる。

【 0 0 1 4 】

第 4 発明によれば、ウェハーの表面に導電バンプを形成する工程と、ウェハーを裏返し、ウェハーの裏面に樹脂層を形成する工程とを備えることを特徴とする半導体チップの製造方法が提供される。

【 0 0 1 5 】

かかる半導体チップの製造方法によれば、ウェハーから切り出される各半導体チップの裏面に樹脂層が形成されることができる。こういった樹脂層によれば、たとえ半導体チップに欠けが生じても微小な欠片は半導体チップ上に留められることができる。微小な欠片の落下や飛び散りは防止される。樹脂層の働きで半導体チップに起因する塵埃の発生はできる限り抑制されることができる。

【 0 0 1 6 】

こういった樹脂層を形成するにあたって、半導体チップの製造方法は、薄膜部材の表面に付着する樹脂膜をウェハーの裏面に転移させる工程をさらに備えてもよい。こうした転移によれば、ウェハーに含まれる個々の半導体チップに対して一括して樹脂層は形成されることができる。したがって、各半導体チップごとに個別に樹脂層が形成される場合に比べて、作業時間は著しく短縮されることがで

きる。しかも、このように予め各半導体チップに樹脂層が形成されれば、後続する半導体チップの実装作業は簡素化されることができる。

【0017】

【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照しつつ本発明の一実施形態を説明する。

【0018】

図1はプリント基板ユニット11の構造を概略的に示す。このプリント基板ユニット11は、表面に導電配線パターンが描かれるプリント配線基板12と、このプリント配線基板12に実装された半導体チップ13とを備える。プリント配線基板12では、例えばポリイミドといった合成樹脂製絶縁層14の表面に導電配線パターンは形成される。絶縁層14は例えばステンレス製の薄板といった基材15の表面に形成されればよい。その一方で、絶縁層14のみでいわゆるフレキシブルプリント基板(FPC)が構成されてもよい。その他、導電配線パターンは例えばセラミック製の薄板といった基材の表面に形成されてもよい。

【0019】

半導体チップ13は、半導体回路が作り込まれたチップ本体17と、このチップ本体17の表面(下向き面)から突出して導電配線パターンの一部すなわち入出力パッド18に受け止められる1以上の入出力バンプ19とを備える。入出力バンプ19は入出力パッド18に接合される。この接合によってチップ本体17と導電配線パターンとの間に電気接続は確立される。

【0020】

チップ本体17の背面(上向き面)には樹脂層21が積層される。この樹脂層21はチップ本体17の背面全体を覆う。樹脂層21の形成には、熱硬化樹脂材のほか、紫外線硬化樹脂材といった光硬化樹脂材、紫外線熱硬化樹脂材のように熱および光を併用する硬化樹脂材が用いられればよい。

【0021】

こういった樹脂層21によれば、たとえチップ本体17に欠けが生じてても微小な欠片はチップ本体17上に留められることができる。微小な欠片の落下や飛び散りは防止される。こういった半導体チップ13は、例えばハードディスク駆動

装置（HDD）の筐体内に組み込まれて使用されることができる。HDDの筐体内では、磁気ディスクの損傷などを引き起こす塵埃の発生は可能な限り抑制されることが求められる。

【0022】

次に半導体チップ13の製造方法を詳述する。この製造にあたって、図2に示されるように、例えば円盤形のシリコンウェハー23が用意される。1枚のシリコンウェハー23には例えば6000～7000個の半導体回路が作り込まれる。各半導体回路は最終的に個々の半導体チップ13に切り出される。

【0023】

加えて、この製造方法を実施するにあたって第1および第2材料供給テープ24、25が準備される。例えば第1材料供給テープ24は、図3から明らかなように、薄膜部材すなわちフィルムテープ26の表面に付着する樹脂膜27を備える。樹脂膜27はシリコンウェハー23と同一の形状に形作られる。樹脂膜27は一定の間隔でフィルムテープ26の長手方向に配列されればよい。図4に示されるように、この樹脂膜27の厚みは例えば t_1 [μm] に設定される。

【0024】

フィルムテープ26は例えばポリ塩化ビニル（PVC）やポリエチレンテレフタレート（PET）といった素材から形成されればよい。ここでは、フィルムテープ26は紫外線の透過を許容する。その一方で、樹脂膜27の形成には例えば紫外線硬化性接着剤が用いられればよい。このとき、紫外線硬化性接着剤にはシラン系カップリング材が混入される。こうしたカップリング材の混入によれば、紫外線硬化性接着剤は、PVCやPETに比べてシリコンに対して高い接着力を発揮することができる。

【0025】

図5から明らかなように、第2材料供給テープ25は、同様にPVCやPETの薄膜部材すなわちフィルムテープ28の表面に付着するアンダーフィル材膜29を備える。アンダーフィル材膜29はシリコンウェハー23よりも一回り小さく形作られる。アンダーフィル材膜29は一定の間隔でフィルムテープ28の長手方向に配列されればよい。図6に示されるように、このアンダーフィル材膜2

9の厚みは例えば t_2 [μm] に設定される。

【0026】

ここで、アンダーフィル材膜29には例えば常温で所定の粘着力が与えられる。この粘着力でアンダーフィル材膜29はフィルムテープ28の表面に付着する。ただし、このアンダーフィル材膜29は、例えば70℃程度で軟化するとともに150℃程度で硬化する。このようなアンダーフィル材膜29は例えば熱硬化性接着剤と熱可塑性樹脂との混合物から形成されることができる。例えばビスフェノール系エポキシ樹脂にイミダゾールといった硬化材が混入されると熱硬化性接着剤は得られる。このとき、熱硬化性接着剤に例えば50重量%程度のポリアミドイミドが配合されれば、前述のアンダーフィル材膜29は形成されることができる。

【0027】

その他、半導体チップ13の製造方法を実現するにあたって、例えば図7に示されるように、例えばステンレス製の環状部材31が用意される。図7から明らかのように、この環状部材31の内径はシリコンウェハー23の外径よりも大きく設定される。しかも、この環状部材31には、図8に示されるように、相互に平行な2平面で規定される第1および第2基準面32、33が形成される。樹脂膜27およびアンダーフィル材膜29の厚み t_1 、 t_2 にシリコンウェハー23の厚みが足し合わせられると、2平面の距離すなわち環状部材31の厚み t_3 [μm] に相当する。

【0028】

まず、図9に示されるように、シリコンウェハー23の表面には金製の入出力バンプ19が形成される。こうした入出力バンプ19は、周知の通り、ワイヤボンディングの要領で形成されてもよく、電解めっきの要領で形成されてもよい。例えばワイヤボンディングの要領で入出力バンプ19が形成されると、図9から明らかのように、入出力バンプ19の先端には尖った頂点が形成される。頂点の高さは前述のアンダーフィル材膜29の厚み t_2 に合わせ込まれる。入出力バンプ19の形成にあたっては、金属材料のほか、半田その他の導電性材料が用いられ、てもよい。

【0029】

図10に示されるように、シリコンウェハー23は、裏返された後に第1作業ステージ34の水平面35に搭載される。裏返されたシリコンウェハー23の表面では入出力パンプ19は下向きに突出する。第1作業ステージ34の水平面35には、下向きの入出力パンプ19を収容する例えば円形の受け入れ穴36が形成される。シリコンウェハー23の外縁は受け入れ孔36の周囲で水平面35に受け止められる。

【0030】

このとき、第1作業ステージ34の水平面35には、受け入れ穴36を取り巻く環状溝37が形成される。環状溝37の深さD1はアンダーフィル材膜29の厚み t_2 に合わせ込まれる。この環状溝37に環状部材31は取り外し可能にはめ込まれる。水平面35から第1基準面32までの高さはシリコンウェハー23および樹脂膜27の総厚みに相当する。

【0031】

続いて第1作業ステージ34では、図11に示されるように、第1材料供給テープ24が環状部材31の第1基準面32に重ね合わせられる。第1材料供給テープ24は、例えば加圧ローラ38の働きで第1作業ステージ34の水平面35に向けて押し付けられる。その結果、第1材料供給テープ24のフィルムテープ26は環状部材31の第1基準面32に剥離可能に接着される。フィルムテープ26の表面に付着する樹脂膜27はシリコンウェハー23の裏面に押し付けられる。

【0032】

その後、第1材料供給テープ24は、図12に示されるように、環状部材31に沿って切り抜かれる。切り抜かれたフィルムテープ26は環状部材31とシリコンウェハー23との連結を維持する。樹脂膜27の接着力で、フィルムテープ26と樹脂膜27との密着や、樹脂膜27とシリコンウェハー23との密着は維持される。

【0033】

図13に示されるように、シリコンウェハー23は、再び裏返された後に第2

作業ステージ 39 の水平面 40 に搭載される。シリコンウェハー 23 は裏面で水平面 40 に受け止められる。この第 2 作業ステージ 39 では、図 14 に示されるように、第 2 材料供給テープ 25 が環状部材 31 の第 2 基準面 33 に重ね合わせられる。このとき、第 2 材料供給テープ 25 は 70℃ 程度まで加熱される。この加熱によって第 2 材料供給テープ 25 ではアンダーフィル材膜 29 は軟化する。

【0034】

例えば加圧ローラ 41 の働きで第 2 材料供給テープ 25 が第 2 作業ステージ 39 の水平面 40 に向かって押し付けられると、軟化したアンダーフィル材膜 29 に入出力バンプ 19 は食い込んでいく。入出力バンプ 19 の先端は、アンダーフィル材膜 29 を貫通してフィルムテープ 28 に到達する。その後、アンダーフィル材膜 29 が常温まで冷却されると、アンダーフィル材膜 29 は再び硬化する。アンダーフィル材膜 29 の硬化後、図 15 に示されるように、第 2 材料供給テープ 25 のフィルムテープ 28 は剥離される。こうしてフィルムテープ 28 の表面に付着するアンダーフィル材膜 29 はシリコンウェハー 23 の表面に転移される。冷却や剥離に先立って、第 2 材料供給テープ 25 は環状部材 31 に沿って切り抜かれてもよい。

【0035】

こうしてアンダーフィル材膜 29 の転移が完了すると、図 16 に示されるように、シリコンウェハー 23 にはダイシング加工が施される。シリコンウェハー 23 は各半導体チップ 13 に切断される。半導体チップ 13 の製造は完了する。ここで、樹脂膜 27 に紫外線が照射されると、シリコンウェハー 23 すなわち各半導体チップ 13 の裏面で樹脂膜 27 は硬化する。シラン系カップリング剤の働きで、樹脂膜 27 とシリコンウェハ 23 すなわちチップ本体 17 との密着は維持される一方で、樹脂膜 27 とフィルムテープ 26 との間の接着力は弱められる。したがって、各半導体チップ 13 はフィルムテープ 26 から拾い上げられることができる。こうして拾い上げられた半導体チップ 13 は続いてプリント配線基板 12 に実装されればよい。

【0036】

ここでは、各半導体チップ 13 が切り出された後、図 17 に示されるように、

環状部材 31 の第 2 基準面 33 にフィルムテープ 42 が覆い被せられる。フィルムテープ 42 には予め粘着力が付与される。例えば加圧ローラ 43 の働きで第 2 作業ステージ 39 の水平面 40 に向かってフィルムテープ 42 が押し付けられると、フィルムテープ 42 と環状部材 31 やアンダーフィル材膜 29 との間で接着は確立される。こうしてシリコンウェハー 23 すなわち全ての半導体チップ 13 はフィルムテープ 26、42 同士の上に挟み込まれる。フィルムテープ 42 は環状部材 31 に沿って切り抜かれる。

【0037】

こうしてフィルムテープ 42 が接着されると、図 18 に示されるように、フィルムテープ 42 との間にシリコンウェハー 23 すなわち全ての半導体チップ 13 を挟み込んだままフィルムテープ 26 は裏返される。その結果、シリコンウェハー 23 は再び裏返される。裏返されたシリコンウェハー 23 には紫外線が照射される。その結果、シリコンウェハー 23 すなわち各半導体チップ 13 の裏面で樹脂膜 27 は硬化する。前述したように、シラン系カップリング剤の働きで、樹脂膜 27 と半導体チップ 13 との密着は維持される一方で、樹脂膜 27 とフィルムテープ 26 との間の接着力は弱められる。

【0038】

こうして樹脂膜 27 とフィルムテープ 26 との接着力が弱められると、図 19 に示されるように、フィルムテープ 26 は半導体チップ 13 から剥離されることが出来る。フィルムテープ 26 が剥離されても、樹脂膜 27 は半導体チップ 13 の裏面に保持される。半導体チップ 13 はフィルムテープ 42 上に維持される。

【0039】

その後、図 20 に示されるように、切り出された各半導体チップ 13 はフィルムテープ 42 から拾い上げられる。拾い上げられた半導体チップ 13 はプリント配線基板 12 上に搭載される。図 21 に示されるように、超音波ヘッド 44 の働きで半導体チップ 13 の入出力パンプ 19 はプリント配線基板 12 上の入出力パッド 18 に接合される。接合後、プリント配線基板 12 に 150℃ 程度の加熱処理が施されると、入出力パンプ 19 の周囲でアンダーフィル材膜 29 は完全に硬化する。こうして半導体チップ 13 の実装は完了する。

【0040】

以上のような実装方法によれば、半導体チップ13は一括で裏返された後、プリント配線基板12に実装される。したがって、個々の半導体チップ13ごとに個別に半導体チップ13が裏返される場合に比べて、著しく作業時間は短縮されることができる。しかも、各半導体チップ13には予めアンダーフィル材が供給されることから、アンダーフィル材の供給作業は簡素化されることができる。特に、アンダーフィル材の供給は、シリコンウェハー23から各半導体チップ13が切り出される以前に実施されることから、各半導体チップ13ごとに個別にアンダーフィル材が供給される場合に比べて、著しく作業時間は短縮されることができる。

【0041】

【発明の効果】

以上のように本発明によれば、半導体チップの実装にあたって作業時間は著しく短縮されることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 プリント基板ユニットの構造を概略的に示す側面図である。

【図2】 シリコンウェハーの平面図である。

【図3】 第1材料供給テープの部分平面図である。

【図4】 第1材料供給テープの部分断面図である。

【図5】 第2材料供給テープの部分平面図である。

【図6】 第2材料供給テープの部分断面図である。

【図7】 環状部材を示す平面図である。

【図8】 図7の8-8線に沿った断面図である。

【図9】 シリコンウェハーの表面に入出力バンプを形成する工程を示す図である。

【図10】 第1作業ステージに裏返しに搭載されたシリコンウェハーの様子を示す図である。

【図11】 シリコンウェハーの裏面に第1材料供給テープを圧着する工程を示す図である。

【図 1 2】 第 1 材料供給テープが切り抜かれた際にシリコンウェハーの様子を示す図である。

【図 1 3】 再び裏返された後に第 2 作業ステージに搭載されたシリコンウェハーの様子を示す図である。

【図 1 4】 シリコンウェハーの表面に第 2 材料供給テープを圧着する工程を示す図である。

【図 1 5】 フィルムテープが剥離された際にシリコンウェハーの様子を示す図である。

【図 1 6】 ダイシング工程で切り出された半導体チップの様子を示す図である。

【図 1 7】 フィルムテープ同士の間挟み込まれた半導体チップの様子を示す図である。

【図 1 8】 再び裏返されたシリコンウェハーすなわち半導体チップの様子を示す図である。

【図 1 9】 樹脂膜からフィルムテープを剥離する工程を示す図である。

【図 2 0】 半導体チップを拾い上げる工程を示す図である。

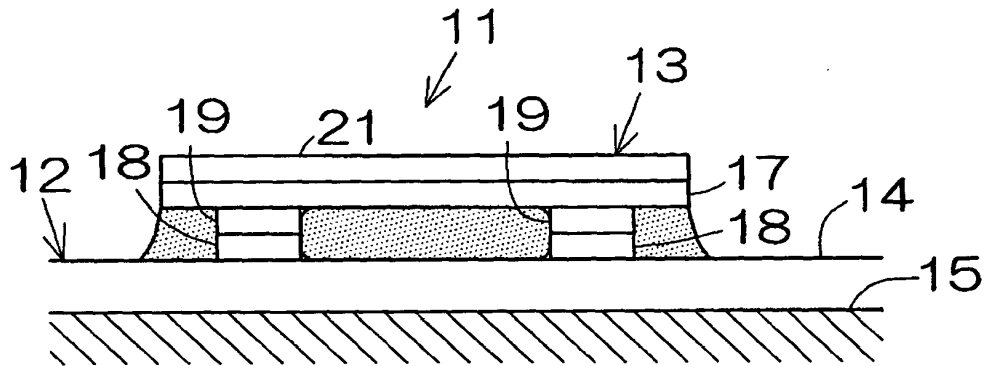
【図 2 1】 プリント配線基板に半導体チップを接合する工程を示す図である。

【符号の説明】

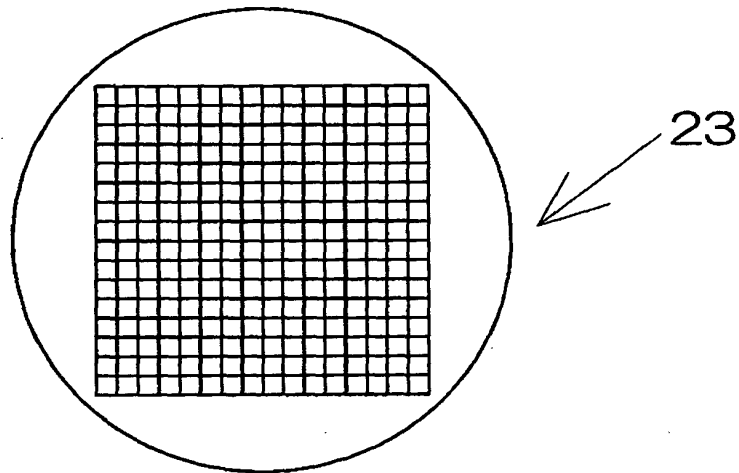
1 2 半導体チップ、1 9 導電バンプとしての入出力バンプ、2 3 ウェハー、2 6 薄膜部材および第 1 支持部材としてのフィルムテープ、2 7 樹脂膜、2 8 薄膜部材としてのフィルムテープ、2 9 アンダーフィル材膜、4 2 第 2 支持部材としてのフィルムテープ。

【書類名】 図面

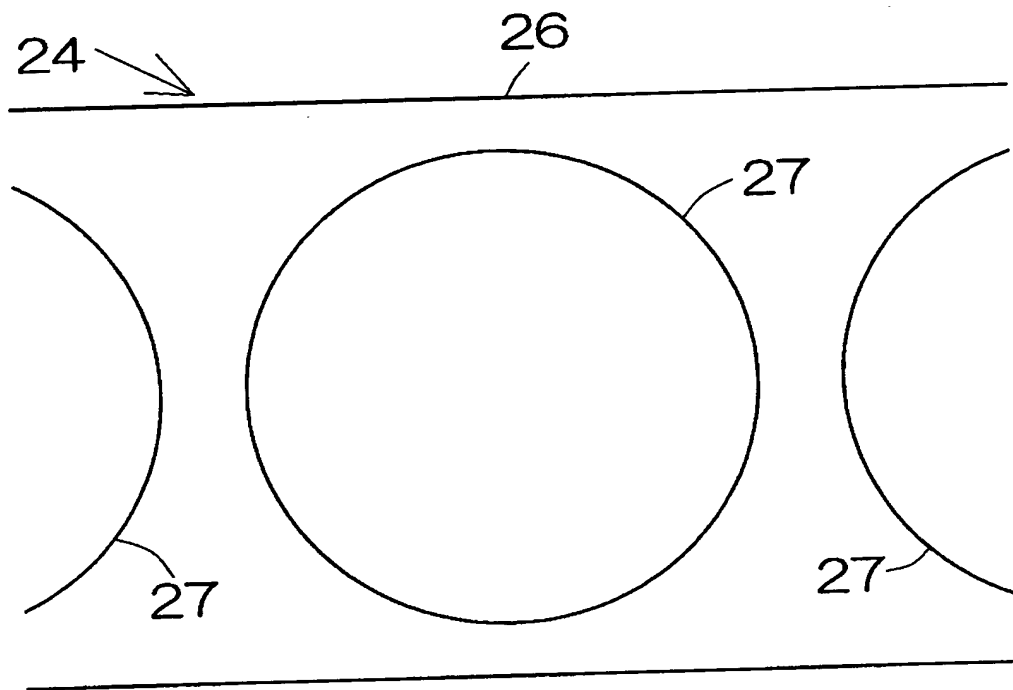
【図 1】



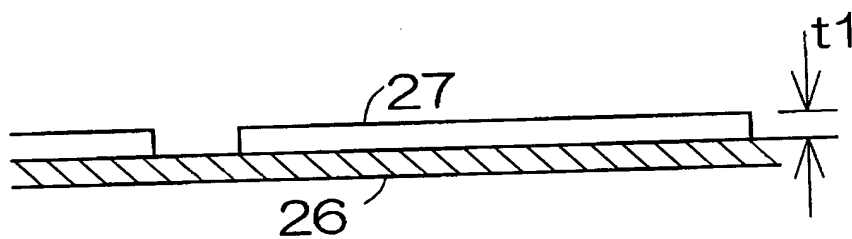
【図 2】



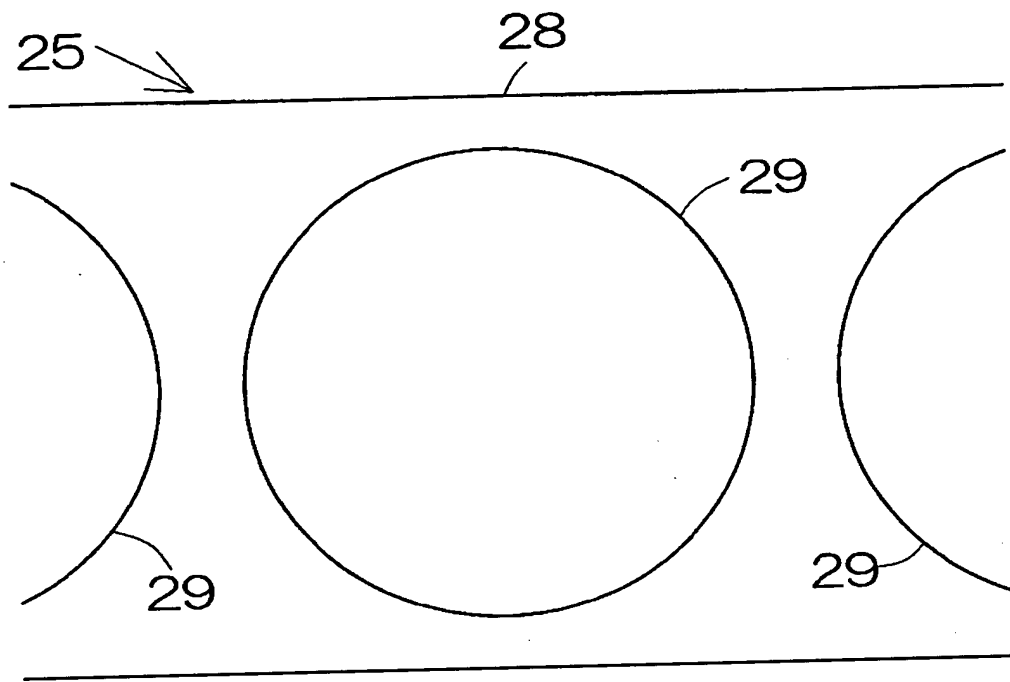
【図3】



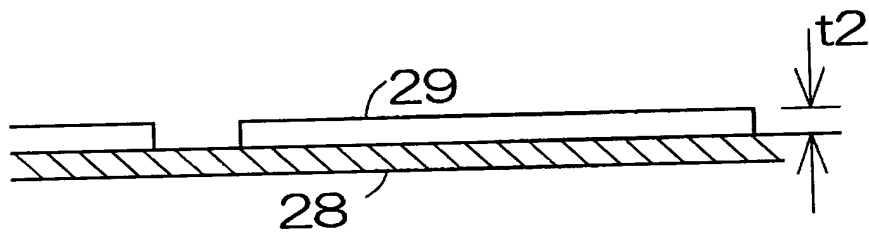
【図4】



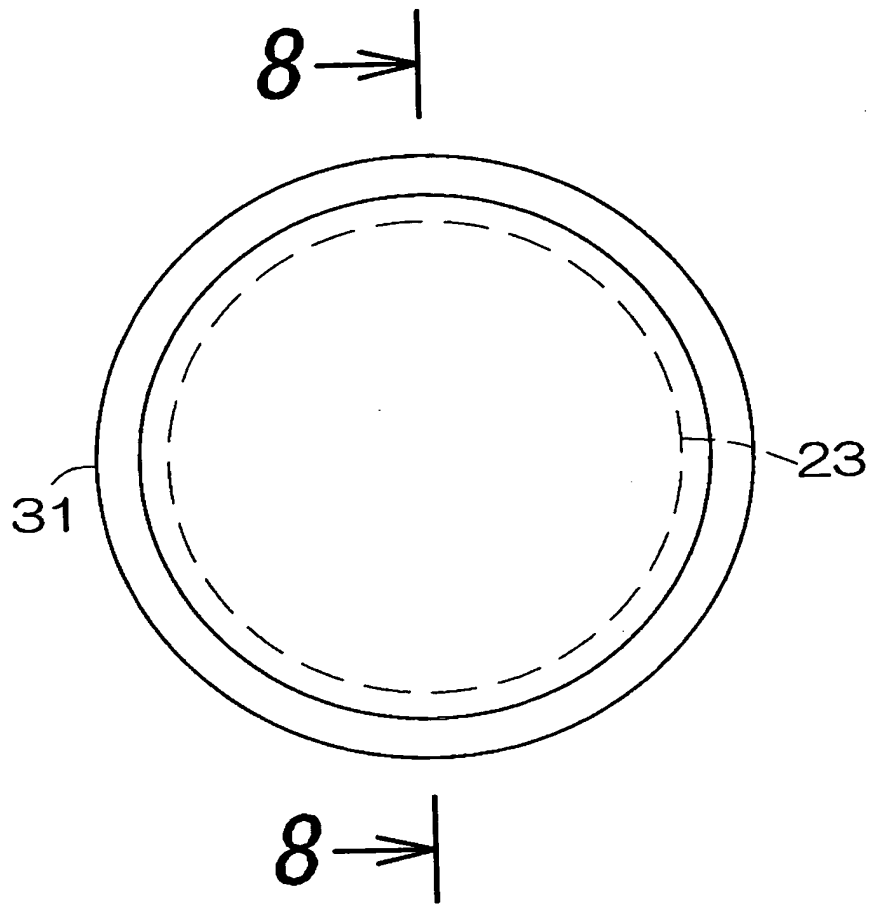
【図5】



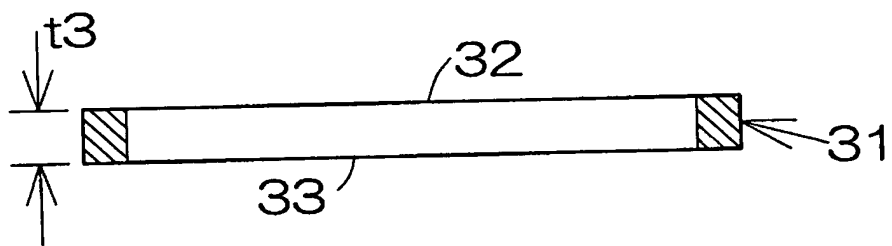
【図6】



【図 7】



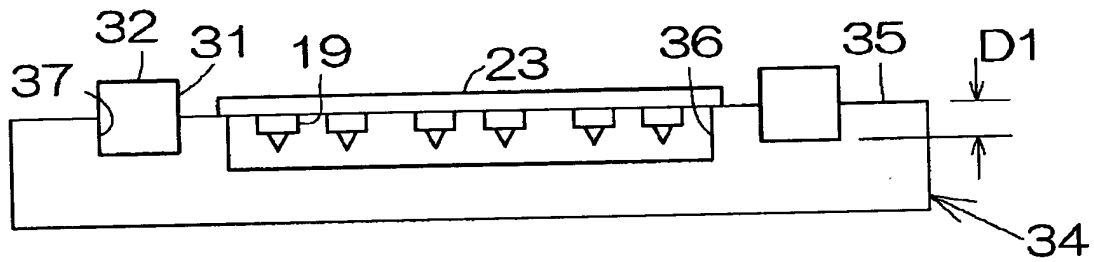
【図 8】



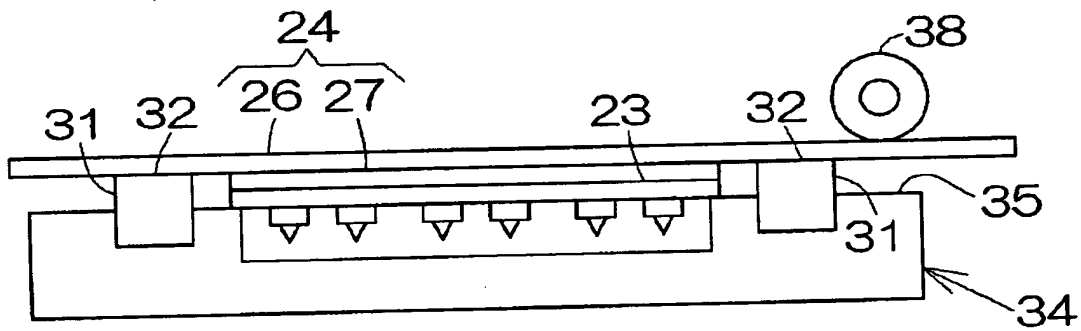
【図 9】



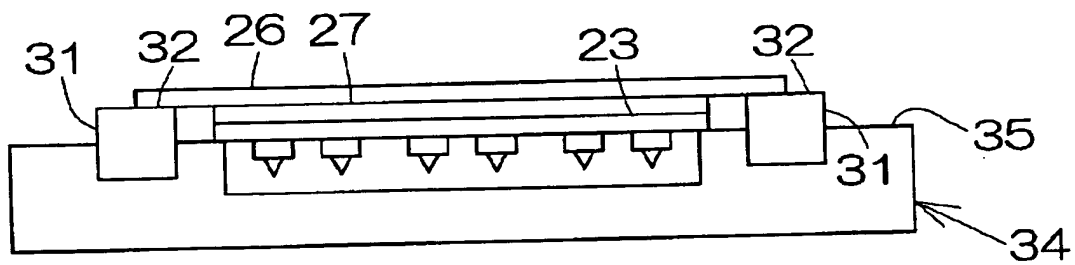
【図 10】



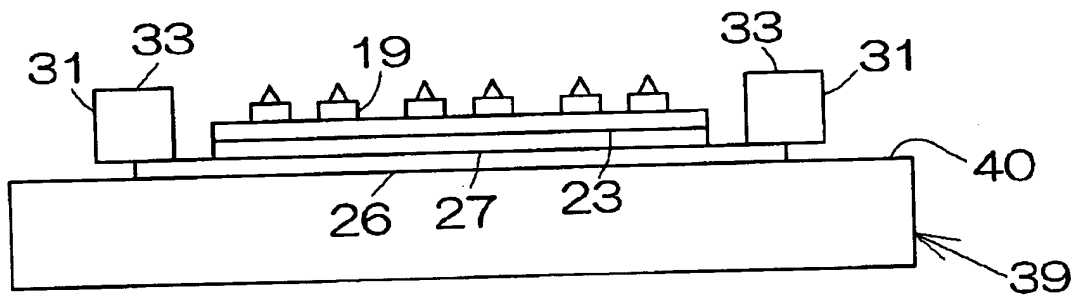
【図 11】



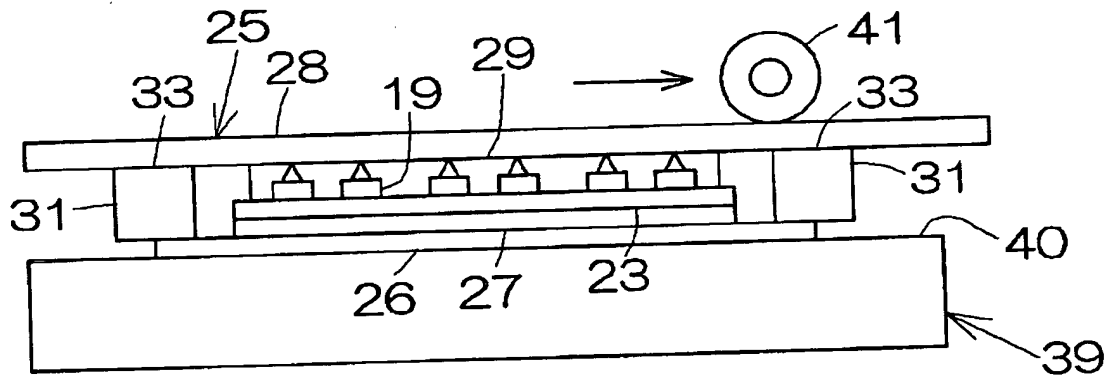
【図 12】



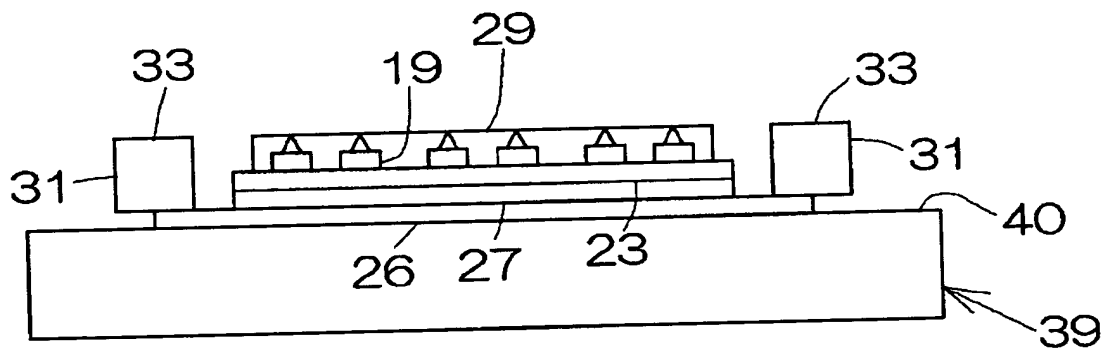
【図13】



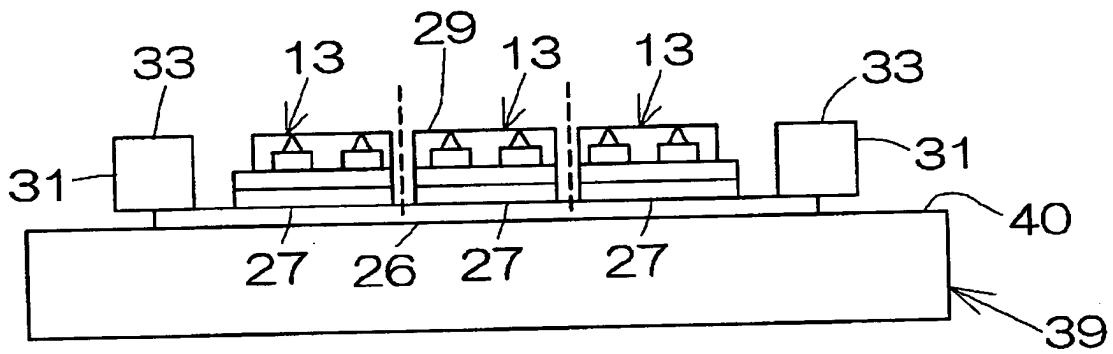
【図14】



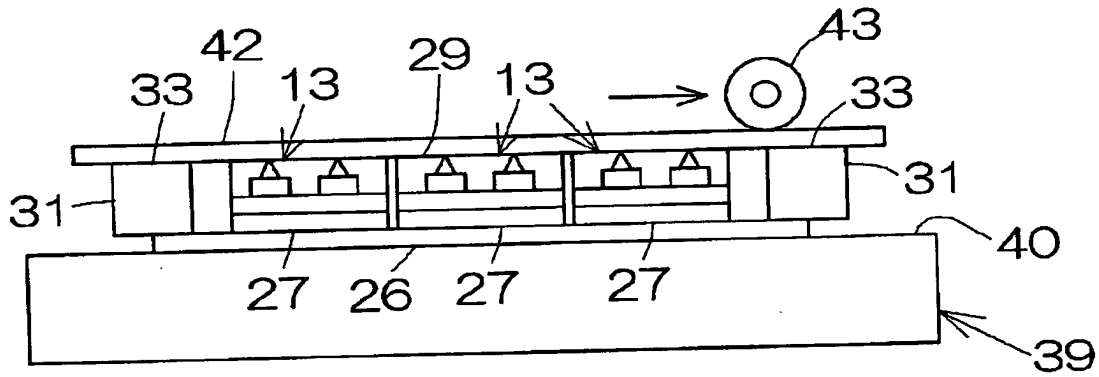
【図15】



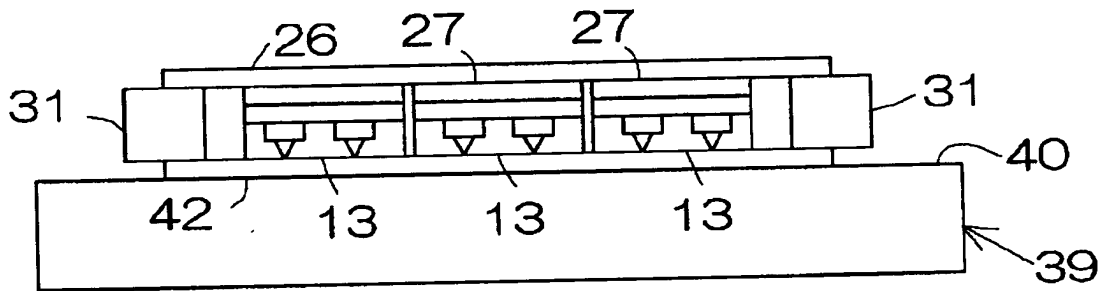
【図 16】



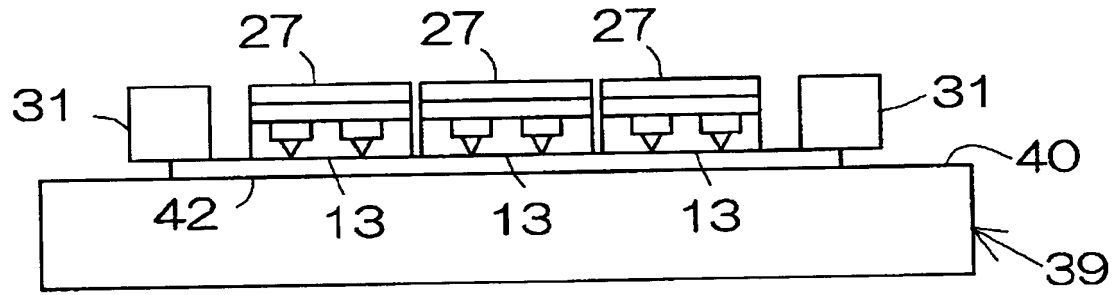
【図 17】



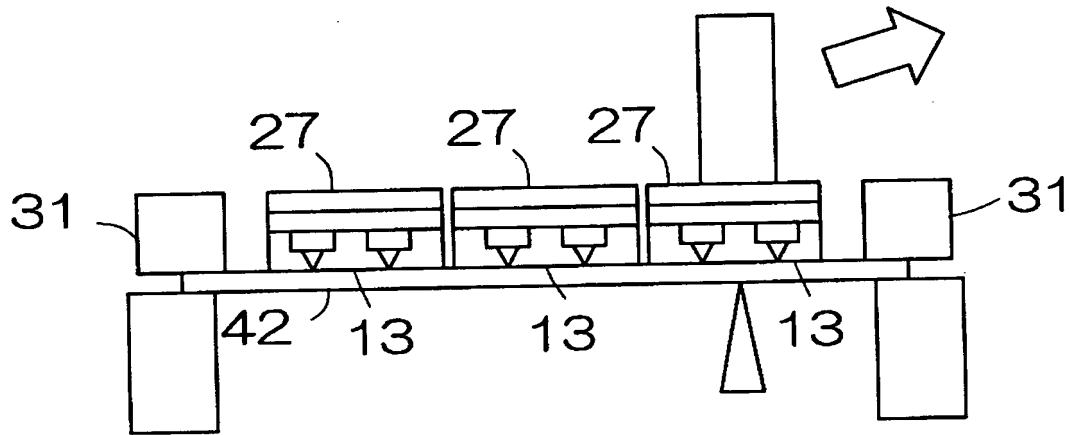
【図 18】



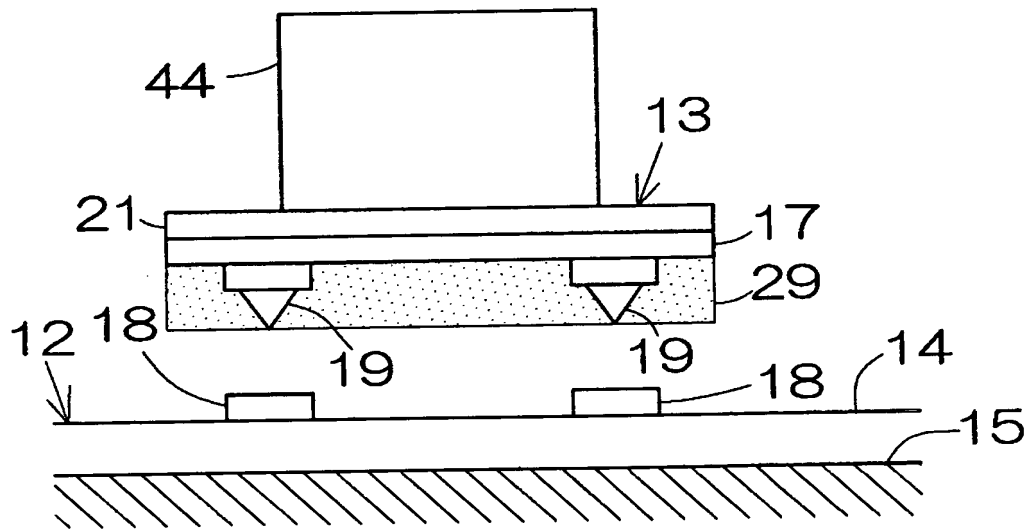
【図19】



【図20】



【図21】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 半導体チップの実装にあたって作業時間を短縮することができる半導体チップの実装方法を提供する。

【解決手段】 導電バンプ 1 9 を突出させるウェハー 2 3 は作業ステージ 3 9 に設置される。ウェハー 2 3 の表面には、薄膜部材 2 8 の表面に付着するアンダーフィル材膜 2 9 が押し付けられる。このとき、アンダーフィル材膜 2 9 は軟化させられる。導電バンプ 1 9 はアンダーフィル材膜 2 9 を貫通する。アンダーフィル材膜 2 9 を硬化させた上でアンダーフィル材膜 2 9 から薄膜部材 2 8 は剥離される。こうしてウェハー 2 3 に含まれる個々の半導体チップに対して一括してアンダーフィル材は供給される。したがって、各半導体チップごとに個別にアンダーフィル材が供給される場合に比べて、作業時間は著しく短縮されることができる。

【選択図】 図 1 4

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005223]

1. 変更年月日 1996年 3月26日

[変更理由] 住所変更

住 所 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

氏 名 富士通株式会社